



低放射、 絶縁型 DC/DC コンバータ

ADuM5020/ADuM5028

データシート

特長

- isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
- ADuM5020 の 100mA 出力電流
- ADuM5028 の 60 mA 出力電流
- 最大負荷時の 2 層 PCB で、CISPR22 Class B 放射制限に適合
- 最小沿面距離 7.8mm の 16 ピン SOIC_W パッケージ
- 最小沿面距離 8.3mm の 8 ピン SOIC_IC パッケージ
- 高温動作：最高 125°C
- 安全性と規制に対する認定

UL 認定（申請中）：

- 1 分間で 3000V rms、UL 1577 規格に準拠
- CSA Component Acceptance Notice 5A（申請中）
- VDE 適合性認定（申請中）
- VDE V 0884-10
- $V_{IORM} = 565 \text{ V peak}$
- GB4943.1-2011 に準拠する CQC 認定

アプリケーション

- RS-485/RS-422/CAN トランシーバ電源
- 電源スタートアップ・バイアスとゲート・ドライブ
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用 PLC

概要

ADuM5020 および ADuM5028¹ は、isoPower® を搭載した絶縁型の DC/DC コンバータです。アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースとした DC/DC コンバータは、安定化された絶縁型電源を提供します。ここでは、フェライトを搭載した 2 層プリント回路基板 (PCB) に最大の負荷がかかった場合でも、CISPR22 Class B 制限を下回る安定した電力が確保されます。コモン電圧の組合せおよび関連する電流出力レベルを表 1～表 4 に示します。

ADuM5020 および ADuM5028 を使用すると、最大 500mW のアプリケーションで絶縁型 DC/DC コンバータを設計して構築する必要がなくなります。iCoupler チップ・スケール・トランス技術は、

機能ブロック図

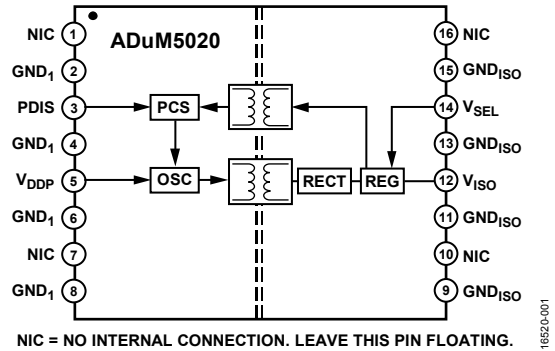


図 1. ADuM5020 の機能ブロック図

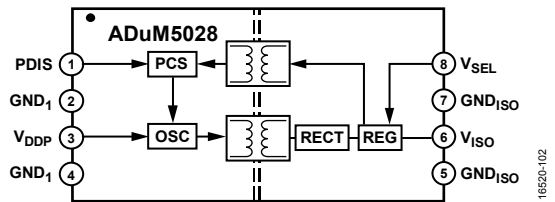


図 2. ADuM5028 の機能ブロック図

DC/DC コンバータの磁気部品に使用されており、絶縁された小型のソリューションが実現しています。

絶縁型 DC/DC コンバータの ADuM5020 および ADuM5028 は、2 種類の異なるパッケージで提供されています。ADuM5020 はワイド・ボディ、16 ピン SOIC_W パッケージで、ADuM5028 は省スペース、8 ピン、ワイド・ボディ SOIC_IC パッケージです。詳細については、ピン配置およびピン機能の説明のセクションとオーダー・ガイドを参照してください。

¹ 米国特許 5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; 7,075,329 により保護されています。その他の特許は申請中です。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいは利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は、予告なく変更される場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。※日本語版資料は REVISION が古い場合があります。最新の内容については、英語版をご参照ください。

目次

特長.....	1	ESDに関する注意.....	9
アプリケーション.....	1	ピン配置およびピン機能の説明.....	10
機能ブロック図.....	1	真理値表.....	10
概要.....	1	代表的な性能特性.....	11
改訂履歴.....	2	動作原理.....	14
仕様.....	3	アプリケーション情報.....	15
電気的特性 — 5V 主入力電源/5V 二次絶縁電源.....	3	PCB レイアウト.....	15
電気的特性 — 5V 主入力電源/3.3 V 二次絶縁電源.....	4	熱解析.....	16
規制に対する認定.....	5	EMIに関する考慮事項.....	16
絶縁および安全性関連の仕様.....	5	絶縁寿命.....	16
パッケージ特性.....	6	外形寸法.....	18
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10) 絶縁特性.....	6	オーダー・ガイド.....	18
推奨動作条件.....	8		
絶対最大定格.....	9		

改訂履歴

6/2018-Revision 0: Initial Version

仕様

電気的特性 - 5V 主入力電源 / 5V 二次絶縁電源

特に指定のない限り、すべての代表的な仕様は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DDP} = V_{ISO} = 5\text{V}$ で規定されます。最小 / 最大仕様には、 $4.5\text{V} \leq V_{DDP} \leq 5.5\text{V}$ 、 $4.5\text{V} \leq V_{ISO} \leq 5.5\text{V}$ 、および $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$ の全推奨動作範囲が適用されます。

表 1. ADuM5020 DC/DC コンバータの静的仕様

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
DC-TO-DC CONVERTER SUPPLY						
Setpoint	V_{ISO}	4.75	5.0	5.25	V	V_{ISO} output current (I_{ISO}) = 10 mA
Line Regulation	$V_{ISO(LINE)}$		2		mV/V	$I_{ISO} = 50\text{ mA}$, $V_{DDP} = 4.5\text{ V to } 5.5\text{ V}$
Load Regulation ¹	$V_{ISO(LOAD)}$		1	5	%	$I_{ISO} = 10\text{ mA to } 90\text{ mA}$
Output Ripple ¹	$V_{ISO(RIP)}$		75		mV p-p	20 MHz bandwidth, bypass output capacitance (C_{BO}) = 0.1 μF 10 μF , $I_{ISO} = 90\text{ mA}$
Output Noise ¹	$V_{ISO(NOISE)}$		200		mV p-p	$C_{BO} = 0.1\ \mu\text{F}$ 10 μF , $I_{ISO} = 90\text{ mA}$
Switching Frequency	f_{OSC}		180		MHz	
Pulse-Width Modulation (PWM) Frequency	f_{PWM}		625		kHz	
Output Supply Current ¹	$I_{ISO(MAX)}$	50			mA	$4.75\text{ V} < V_{ISO} < 5.25\text{ V}$
		100			mA	$4.5\text{ V} < V_{ISO} < 5.25\text{ V}$
Efficiency at $I_{ISO(MAX)}$ ¹			33		%	$I_{ISO} = 100\text{ mA}$
V_{DDP} Supply Current						
No V_{ISO} Load	$I_{DDP(Q)}$		8	25	mA	
Full V_{ISO} Load	$I_{DDP(MAX)}$		310		mA	
Thermal Shutdown						
Shutdown Temperature			154		$^\circ\text{C}$	
Thermal Hysteresis			10		$^\circ\text{C}$	

¹ 最大 V_{ISO} 出力電流は、 $T_A > 85^\circ\text{C}$ の場合、 $1.75\text{ mA}/^\circ\text{C}$ でディレーティングされます。

表 2. ADuM5028 DC/DC コンバータの静的仕様

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
DC-TO-DC CONVERTER SUPPLY						
Setpoint	V_{ISO}	4.75	5.0	5.25	V	$I_{ISO} = 10\text{ mA}$
Line Regulation	$V_{ISO(LINE)}$		2		mV/V	$I_{ISO} = 30\text{ mA}$, $V_{DDP} = 4.5\text{ V to } 5.5\text{ V}$
Load Regulation ¹	$V_{ISO(LOAD)}$		1	5	%	$I_{ISO} = 10\text{ mA to } 54\text{ mA}$
Output Ripple ¹	$V_{ISO(RIP)}$		75		mV p-p	20 MHz bandwidth, $C_{BO} = 0.1\ \mu\text{F}$ 10 μF , $I_{ISO} = 54\text{ mA}$
Output Noise ¹	$V_{ISO(NOISE)}$		200		mV p-p	$C_{BO} = 0.1\ \mu\text{F}$ 10 μF , $I_{ISO} = 54\text{ mA}$
Switching Frequency	f_{OSC}		180		MHz	
PWM Frequency	f_{PWM}		625		kHz	
Output Supply Current ¹	$I_{ISO(MAX)}$	60			mA	$4.75\text{ V} < V_{ISO} < 5.25\text{ V}$
Efficiency at $I_{ISO(MAX)}$ ¹			33		%	$I_{ISO} = 60\text{ mA}$
V_{DDP} Supply Current						
No V_{ISO} Load	$I_{DDP(Q)}$		8	25	mA	
Full V_{ISO} Load	$I_{DDP(MAX)}$		310		mA	
Thermal Shutdown						
Shutdown Temperature			154		$^\circ\text{C}$	
Thermal Hysteresis			10		$^\circ\text{C}$	

¹ 最大 V_{ISO} 出力電流は、 $T_A > 85^\circ\text{C}$ の場合、 $1\text{ mA}/^\circ\text{C}$ でディレーティングされます。

電気的特性 – 5V 主入力電源 / 3.3 V 二次絶縁電源

特に指定のない限り、すべての代表的な仕様は、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_{DDP} = 5.0\text{V}$ 、 $V_{ISO} = 3.3\text{V}$ で規定されます。最小 / 最大仕様は、 $4.5\text{V} \leq V_{DDP} \leq 5.5\text{V}$ 、 $3.0\text{V} \leq V_{ISO} \leq 3.6\text{V}$ 、および $-40^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$ の全推奨動作範囲が適用されます。

表 3. ADuM5020 DC/DC コンバータの静的仕様

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
DC-TO-DC CONVERTER SUPPLY						
Setpoint	V_{ISO}	3.135	3.3	3.465	V	$I_{ISO} = 10\text{ mA}$
Line Regulation	$V_{ISO (LINE)}$		2		mV/V	$I_{ISO} = 50\text{ mA}$, $V_{DDP} = 3.0\text{ V to } 3.6\text{ V}$
Load Regulation ¹	$V_{ISO (LOAD)}$		1	5	%	$I_{ISO} = 10\text{ mA to } 90\text{ mA}$
Output Ripple ¹	$V_{ISO (RIP)}$		50		mV p-p	20 MHz bandwidth, $C_{BO} = 0.1\ \mu\text{F} 10\ \mu\text{F}$, $I_{ISO} = 90\text{ mA}$
Output Noise ¹	$V_{ISO (NOISE)}$		130		mV p-p	$C_{BO} = 0.1\ \mu\text{F} 10\ \mu\text{F}$, $I_{ISO} = 90\text{ mA}$
Switching Frequency	f_{OSC}		180		MHz	
PWM Frequency	f_{PWM}		625		kHz	
Output Supply Current ¹	$I_{ISO (MAX)}$	50			mA	$3.135\text{ V} < V_{ISO} < 3.465\text{ V}$
		100			mA	$3.0\text{ V} < V_{ISO} < 3.465\text{ V}$
Efficiency at $I_{ISO (MAX)}$ ¹			27		%	$I_{ISO} = 100\text{ mA}$
V_{DDP} Supply Current						
No V_{ISO} Load	$I_{DDP (Q)}$		5	18	mA	
Full V_{ISO} Load	$I_{DDP (MAX)}$		250		mA	
Thermal Shutdown						
Shutdown Temperature			154		$^\circ\text{C}$	
Thermal Hysteresis			10		$^\circ\text{C}$	

¹ 最大 V_{ISO} 出力電流は、 $T_A > 85^\circ\text{C}$ の場合、 $1.75\text{mA}/^\circ\text{C}$ でディレーティングされます。

表 4. ADuM5028 DC/DC コンバータの静的仕様

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
DC-TO-DC CONVERTER SUPPLY						
Setpoint	V_{ISO}	3.135	3.3	3.465	V	$I_{ISO} = 10\text{ mA}$
Line Regulation	$V_{ISO (LINE)}$		2		mV/V	$I_{ISO} = 30\text{ mA}$, $V_{DDP} = 3.0\text{ V to } 3.6\text{ V}$
Load Regulation ¹	$V_{ISO (LOAD)}$		1	5	%	$I_{ISO} = 10\text{ mA to } 54\text{ mA}$
Output Ripple ¹	$V_{ISO (RIP)}$		50		mV p-p	20 MHz bandwidth, $C_{BO} = 0.1\ \mu\text{F} 10\ \mu\text{F}$, $I_{ISO} = 54\text{ mA}$
Output Noise ¹	$V_{ISO (NOISE)}$		130		mV p-p	$C_{BO} = 0.1\ \mu\text{F} 10\ \mu\text{F}$, $I_{ISO} = 54\text{ mA}$
Switching Frequency	f_{OSC}		180		MHz	
PWM Frequency	f_{PWM}		625		kHz	
Output Supply Current ¹	$I_{ISO (MAX)}$	60			mA	$3.135\text{ V} < V_{ISO} < 3.465\text{ V}$
Efficiency at $I_{ISO (MAX)}$ ¹			27		%	$I_{ISO} = 60\text{ mA}$
V_{DDP} Supply Current						
No V_{ISO} Load	$I_{DDP (Q)}$		5	18	mA	
Full V_{ISO} Load	$I_{DDP (MAX)}$		250		mA	
Thermal Shutdown						
Shutdown Temperature			154		$^\circ\text{C}$	
Thermal Hysteresis			10		$^\circ\text{C}$	

¹ 最大 V_{ISO} 出力電流は、 $T_A > 85^\circ\text{C}$ の場合、 $1\text{ mA}/^\circ\text{C}$ でディレーティングされます。

規制に対する認定

表 5.

UL (Pending) ¹	CSA (Pending)	VDE (Pending) ²	CQC (Pending)
Recognized Under 1577 Component Recognition Program ¹ Single Protection, 3000 V rms Isolation Voltage File E214100	Approved under CSA Component Acceptance Notice 5A CSA 60950-1-07+A1+A2 and IEC 60950-1, second edition, +A1+A2 Basic insulation at 780 V rms (1103 V peak) Reinforced insulation at 390 V rms (552 V peak) IEC 60601-1 Edition 3.1: Basic insulation (1 means of patient protection (1 MOPP)), 585 V rms (827 V peak) CSA 61010-1-12 and IEC 61010-1 third edition: Basic insulation at 300 V rms mains, 780 V rms (1103 V peak) Reinforced insulation at 300 V rms mains, 390 V rms (552 V peak) File 205078	DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 Reinforced insulation 565 V peak, surge isolation voltage (V_{IOSM}) = 6000 V peak Transient voltage (V_{IOTM}) = 4242 V peak File 2471900-4880-0001	Certified under CQC11-471543-2012 GB4943.1-2011: Basic insulation at 780 V rms (1103 V peak) Reinforced insulation at 390 V rms (552 V peak) File (pending)

¹ UL 1577 に従い、各 ADuM5020 および ADuM5028 に対して、3600V rms 以上の絶縁テスト電圧を 1 秒間印加する耐電圧テストを実施しています。

² DIN V VDE V 0884-10 に従い、各 ADuM5020 および ADuM5028 に対して、1059V peak 以上の絶縁テスト電圧を 1 秒間印加する耐電圧テストを実施しています（部分放電検出限界 = 5pC）。デバイス表面に付いたアスタリスク (*) は、DIN V VDE V 0884-10 認定製品であることを示します。

絶縁および安全性関連の仕様

詳細については、www.analog.com/icouplersafety を参照してください。

表 6. ADuM5020 の絶縁および安全性

Parameter	Symbol	Value	Unit	Test Conditions/Comments
Rated Dielectric Insulation Voltage		3000	V rms	1-minute duration
Minimum External Air Gap (Clearance)	L (I01)	7.8	mm min	Measured from input terminals to output terminals, shortest distance through air
Minimum External Tracking (Creepage)	L (I02)	7.8	mm min	Measured from input terminals to output terminals, shortest distance path along body
Minimum Clearance in the Plane of the Printed Circuit Board (PCB Clearance)	L (PCB)	8.3	mm min	Measured from input terminals to output terminals, shortest distance through air, line of sight, in the PCB mounting plane
Minimum Internal Gap (Internal Clearance)		25.5	μm min	Insulation distance through insulation
Tracking Resistance (Comparative Tracking Index)	CTI	>600	V	DIN IEC 112/VDE 0303 Part 1
Material Group		I		Material Group (DIN VDE 0110, 1/89, Table 1)

表 7. ADuM5028 の絶縁および安全性

Parameter	Symbol	Value	Unit	Test Conditions/Comments
Rated Dielectric Insulation Voltage		3000	V rms	1-minute duration
Minimum External Air Gap (Clearance)	L (I01)	8.3	mm min	Measured from input terminals to output terminals, shortest distance through air
Minimum External Tracking (Creepage)	L (I02)	8.3	mm min	Measured from input terminals to output terminals, shortest distance path along body
Minimum Clearance in the Plane of the Printed Circuit Board (PCB Clearance)	L (PCB)	8.3	mm min	Measured from input terminals to output terminals, shortest distance through air, line of sight, in the PCB mounting plane
Minimum Internal Gap (Internal Clearance)		25.5	μm min	Insulation distance through insulation
Tracking Resistance (Comparative Tracking Index)	CTI	>600	V	DIN IEC 112/VDE 0303 Part 1
Material Group		I		Material Group (DIN VDE 0110, 1/89, Table 1)

パッケージ特性

表 8. ADuM5020 のパッケージ特性

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
Resistance (Input to Output) ¹	R _{I-O}		10 ¹³		Ω	
Capacitance (Input to Output) ¹	C _{I-O}		2.2		pF	f = 1 MHz
Input Capacitance ²	C _I		4.0		pF	
IC Junction to Ambient Thermal Resistance	θ _{JA}		45		°C/W	Thermocouple located at center of package underside ³

¹ このデバイスは 2 端子デバイスとみなされます。すなわち、ピン 1～ピン 8 を相互に接続し、ピン 9～ピン 16 を相互に接続します。

² 入力容量は任意の入力データ・ピンとグラウンドの間の値です。

³ θ_{JA} の値は、JEDEC JESD-51 規格の 2s2p ボードにデバイスを搭載し、自然空冷の下で測定しています。

表 9. ADuM5028 のパッケージ特性

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
Resistance (Input to Output) ¹	R _{I-O}		10 ¹³		Ω	
Capacitance (Input to Output) ¹	C _{I-O}		2.2		pF	f = 1 MHz
Input Capacitance ²	C _I		4.0		pF	
IC Junction to Ambient Thermal Resistance	θ _{JA}		80		°C/W	Thermocouple located at center of package underside ³

¹ このデバイスは 2 端子デバイスとみなされます。すなわち、ピン 1～ピン 4 を相互に接続し、ピン 5～ピン 8 を相互に接続します。

² 入力容量は任意の入力データ・ピンとグラウンドの間の値です。

³ θ_{JA} の値は、JEDEC JESD-51 規格の 2s2p ボードにデバイスを搭載し、自然空冷の下で測定しています。

DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10) 絶縁特性

これらのアイソレータは、安全限界データ範囲内の強化絶縁のみに適しています。安全性データの維持は、保護回路によって確保されます。パッケージ表面に付いたアスタリスク (*) マーキングは、DIN V VDE V 0884-10 認定製品であることを表します。

表 10. ADuM5020 の VDE 特性

Description	Test Conditions/Comments	Symbol	Characteristic	Unit
Installation Classification per DIN VDE 0110 For Rated Mains Voltage ≤ 150 V rms For Rated Mains Voltage ≤ 300 V rms For Rated Mains Voltage ≤ 400 V rms			I to IV I to III I to II	
Climatic Classification			40/125/21	
Pollution Degree per DIN VDE 0110, Table 1			2	
Maximum Working Insulation Voltage		V _{IORM}	565	V peak
Input to Output Test Voltage, Method b1	V _{IORM} × 1.875 = V _{PR} , 100% production test, t _m = 1 sec, partial discharge < 5 pC	V _{PR}	1059	V peak
Input to Output Test Voltage, Method a After Environmental Tests Subgroup 1	V _{IORM} × 1.5 = V _{pd(m)} , t _{ini} = 60 sec, t _m = 10 sec, partial discharge < 5 pC	V _{PR} V _{pd(m)}	848	V peak
After Input or Safety Test Subgroup 2 and Subgroup 3	V _{IORM} × 1.2 = V _{pd(m)} , t _{ini} = 60 sec, t _m = 10 sec, partial discharge < 5 pC	V _{pd(m)}	678	V peak
Highest Allowable Overvoltage	Transient overvoltage, t _{TR} = 10 sec	V _{IOTM}	4242	V peak
Withstand Isolation Voltage	1 minute withstand rating	V _{ISO}	3000	V rms
Surge Isolation Voltage Reinforced	V _{IOSM(TEST)} = 10 kV; 1.2 μs rise time; 50 μs, 50% fall time	V _{IOSM}	6000	V peak
Safety Limiting Values	Maximum value allowed in the event of a failure (see 図 3)			
Case Temperature		T _S	150	°C
Total Power Dissipation at 25°C		I _{S1}	2.78	W
Insulation Resistance at T _S	V _{IO} = 500 V	R _S	>10 ⁹	Ω

表 11. ADuM5028 の VDE 特性

Description	Test Conditions/Comments	Symbol	Characteristic	Unit
Installation Classification per DIN VDE 0110 For Rated Mains Voltage ≤ 150 V rms For Rated Mains Voltage ≤ 300 V rms For Rated Mains Voltage ≤ 400 V rms			I to IV I to III I to II	
Climatic Classification			40/125/21	
Pollution Degree per DIN VDE 0110, Table 1			2	
Maximum Working Insulation Voltage		V_{IORM}	565	V peak
Input to Output Test Voltage, Method b1	$V_{IORM} \times 1.875 = V_{PR}$, 100% production test, $t_m = 1$ sec, partial discharge < 5 pC	V_{PR}	1059	V peak
Input to Output Test Voltage, Method a After Environmental Tests Subgroup 1	$V_{IORM} \times 1.5 = V_{pd(m)}$, $t_{ini} = 60$ sec, $t_m = 10$ sec, partial discharge < 5 pC	V_{PR} $V_{pd(m)}$	848	V peak
After Input and/or Safety Test Subgroup 2 and Subgroup 3	$V_{IORM} \times 1.2 = V_{pd(m)}$, $t_{ini} = 60$ sec, $t_m = 10$ sec, partial discharge < 5 pC	$V_{pd(m)}$	678	V peak
Highest Allowable Overvoltage	Transient overvoltage, $t_{TR} = 10$ sec	V_{IOTM}	4242	V peak
Withstand Isolation Voltage	1 minute withstand rating	V_{ISO}	3000	V rms
Surge Isolation Voltage Reinforced Safety Limiting Values	$V_{IOSM(TEST)} = 10$ kV; 1.2 μ s rise time; 50 μ s, 50% fall time Maximum value allowed in the event of a failure (see Figure 4)	V_{IOSM}	6000	V peak
Case Temperature		T_S	150	$^{\circ}$ C
Total Power Dissipation at 25 $^{\circ}$ C		I_{S1}	1.56	W
Insulation Resistance at T_S	$V_{IO} = 500$ V	R_S	$>10^9$	Ω

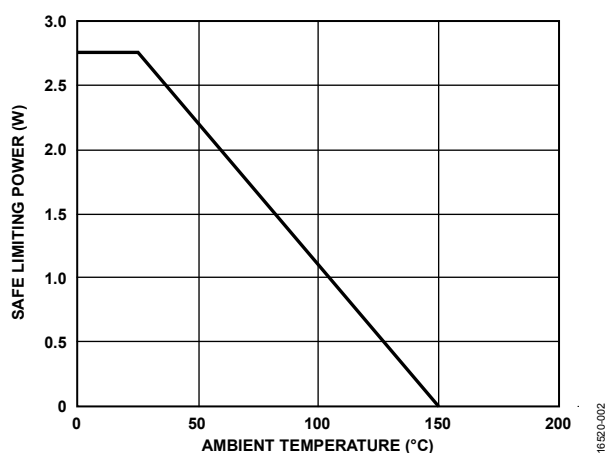


図 3. ADuM5020 の熱ディレーティング曲線、DIN V VDE V 0884-10 による安全限界電力の周辺温度への依存性

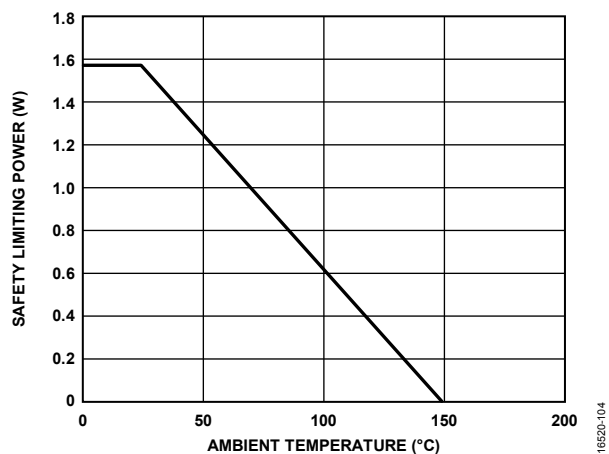


図 4. ADuM5028 の熱ディレーティング曲線、DIN V VDE V 0884-10 による安全限界電力の周辺温度への依存性

推奨動作条件

表 12.

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Operating Temperature ¹	T _A	-40		+125	°C
Supply Voltages ²	V _{DDP}				
V _{DDP} at V _{ISO} = 3.135 V to 3.465 V		4.5		5.5	V
V _{DDP} at V _{ISO} = 4.75 V to 5.25 V		4.5		5.5	V

¹ 85°Cを上回る温度で動作させるには、最大負荷電流を減らす必要があります。

² 各電圧は対応するグラウンドを基準にします。

絶対最大定格

特に指定のない限り、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 。

表 13.

Parameter	Rating
Storage Temperature (T_{ST})	-55°C to $+150^\circ\text{C}$
Ambient Operating Temperature (T_A)	-40°C to $+125^\circ\text{C}$
Supply Voltages (V_{DDP} , V_{ISO}) ¹	-0.5 V to $+7.0\text{ V}$
V_{ISO} Supply Current	
ADuM5020	100 mA
ADuM5028	60 mA
Input Voltage (PDIS, V_{SEL}) ^{1,2}	-0.5 V to $V_{DDI} + 0.5\text{ V}$
Common-Mode Transients ³	$-200\text{ kV}/\mu\text{s}$ to $+200\text{ kV}/\mu\text{s}$

¹すべての電圧は、対応するグラウンドを基準としています。

² V_{DDI} は入力側の電源電圧。

³コモンモード・トランジェントは、絶縁バリアをまたぐコモンモード・トランジェントを表します。絶対最大定格を超えるコモンモード過渡電圧は、ラッチアップまたは恒久的な故障の原因になります。

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格のみを指定するものであり、この仕様の動作のセクションに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。デバイスを長時間にわたり絶対最大定格状態に置くと、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。

表 14. 50年間の最低寿命を実現する最大連続動作電圧¹

Parameter	Max	Unit	Applicable Certification
AC Voltage			
Bipolar Waveform	560	V peak	50-year operation
Unipolar Waveform			
Basic Insulation	560	V peak	50-year operation
DC Voltage			
Basic Insulation	1000	V peak	50-year operation

¹最大連続動作電圧は、絶縁バリアに加わる連続電圧の大きさを表します。詳細については、絶縁寿命のセクションを参照してください。

ESDに関する注意



ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されないうまま放電することがあります。本製品は当社独自の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措置を講じることをお勧めします。

ピン配置およびピン機能の説明

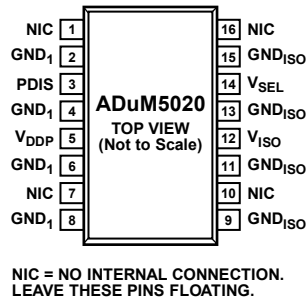


図 5. ピン配置

表 15. ADuM5020 のピン機能の説明

ピン番号	記号	説明
1、7、10、16	NIC	内部接続されていません。これらのピンはフロート状態のままにしておきます。
2、4、6、8	GND ₁	グラウンド 1。1 次側のグラウンド・リファレンス。これらのピンは共通グラウンドに接続することをお勧めします。
3	PDIS	電源ディスエーブル。任意の GND ₁ ピンに接続すると、V _{ISO} 出力電圧がアクティブになります。ロジック・ハイ電圧が印加されると、V _{ISO} 出力電圧はシャットダウンされます。このピンをフロート状態のままにしないでください。
5	V _{DDP}	1 次電源電圧、4.5 V~5.5 V。
9、11、13、15	GND _{ISO}	2 次側の V _{ISO} 用グラウンド・リファレンス。これらのピンは共通グラウンドに接続することをお勧めします。
12	V _{ISO}	外部負荷用の 2 次電源電圧出力。
14	V _{SEL}	出力電圧の選択

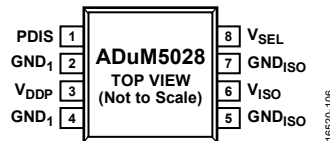


図 6. ADuM5028 のピン配置

表 16. ADuM5028 のピン機能の説明

ピン番号	記号	説明
1	PDIS	電源ディスエーブル。任意の GND ₁ ピンに接続すると、V _{ISO} 出力電圧がアクティブになります。ロジック・ハイ電圧が印加されると、V _{ISO} 出力電圧はシャットダウンされます。このピンをフロート状態のままにしないでください。
2、4	GND ₁	グラウンド 1。1 次側のグラウンド・リファレンス。これらのピンは共通グラウンドに接続することをお勧めします。
3	V _{DDP}	1 次電源電圧、4.5 V~5.5 V。
5、7	GND _{ISO}	2 次側の V _{ISO} 用グラウンド・リファレンス。これらのピンは、まとめて接続することをお勧めします。
6	V _{ISO}	外部負荷用の 2 次電源電圧出力。
8	V _{SEL}	出力電圧の選択 5V 出力の場合は V _{SEL} を V _{ISO} に接続し、3.3V 出力の場合は V _{SEL} を GND _{ISO} に接続します。このピンは、内部プルアップが弱くなっています。したがって、このピンをフロート状態のままにしないでください。

真理値表

表 17. 真理値表 (正ロジック)

V _{DDP} (V)	V _{SEL} Input	PDIS Input	V _{ISO} Output (V)
5	High	Low	5
5	Don't care	High	0
5	Low	Low	3.3
5	Don't care	High	0

代表的な性能特性

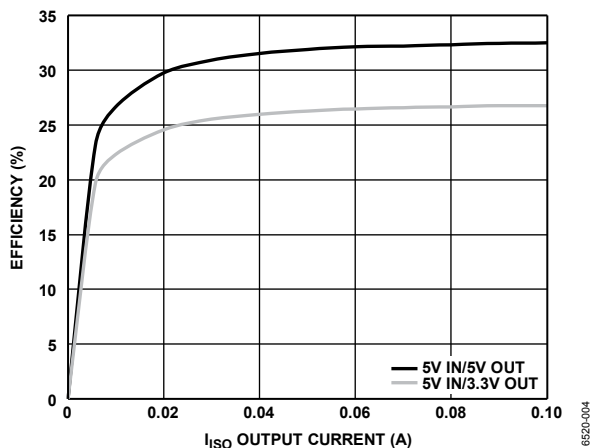


図 7. サポートされる電源構成での代表的な電源効率

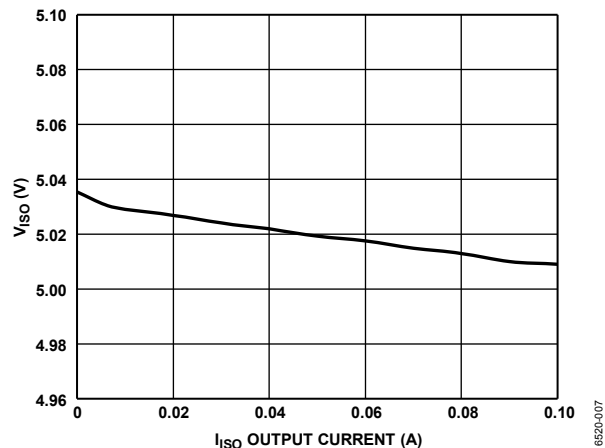


図 10. VISO と IISO 出力電流の関係、入力 = 5V、VISO = 5V

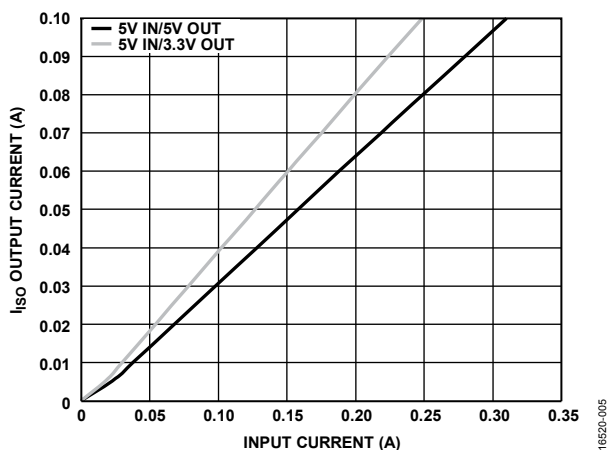


図 8. サポートされる電源構成での IISO 出力電流と入力電流の関係

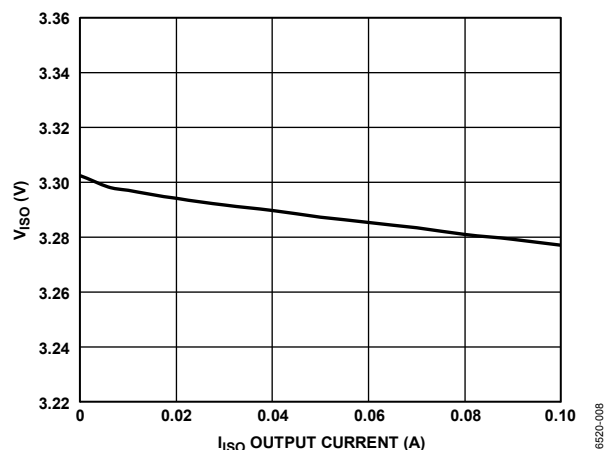


図 11. VISO と IISO 出力電流の関係、入力 = 5V、VISO = 3.3V

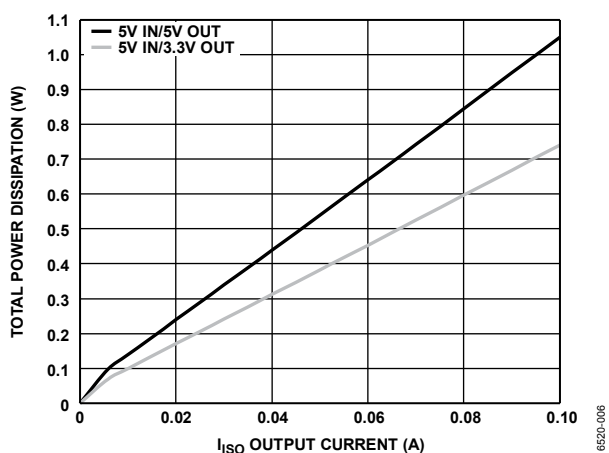


図 9. サポートされる電源構成での合計消費電力と IISO 出力電流の関係

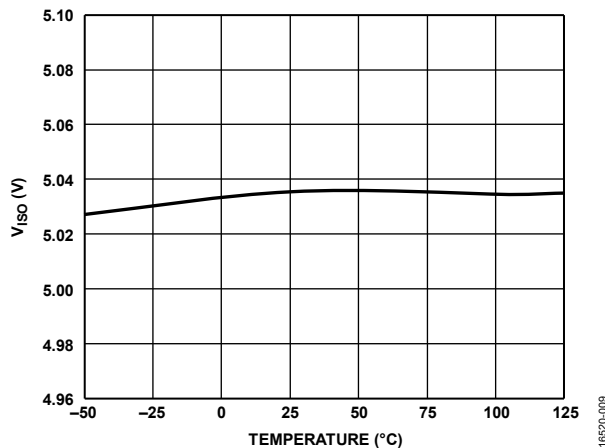


図 12. VISO と温度の関係、入力 = 5V、VISO 出力 = 5V

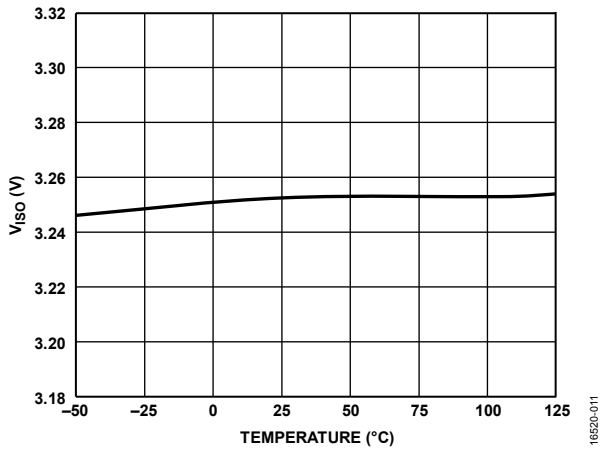


図 13. VISO と温度の関係、入力 = 3.3V、VISO 出力 = 3.3V

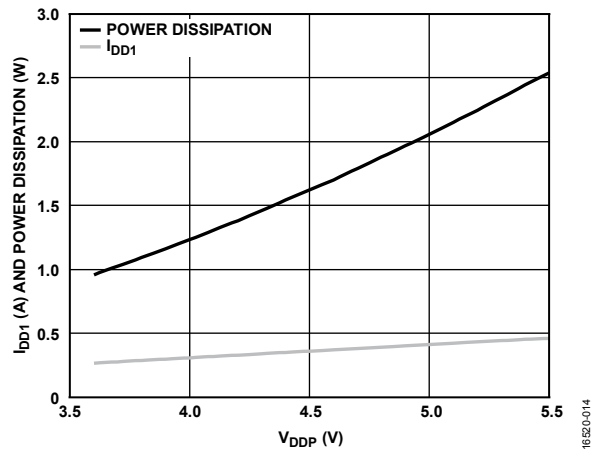


図 16. 短絡入力電流 (IDD1)、消費電力と VDDP の関係

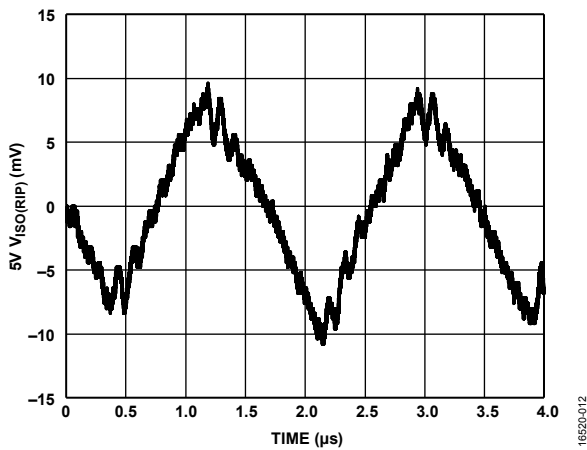


図 14. VISO リップル、90%負荷で入力 5V、出力 5V
帯域幅 = 20MHz

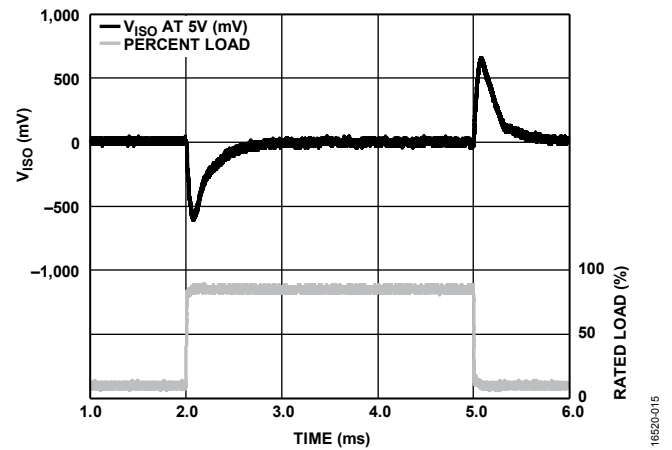


図 17. VISO 過渡負荷応答、入力 5V、出力 5V、10%~90%の
負荷ステップ

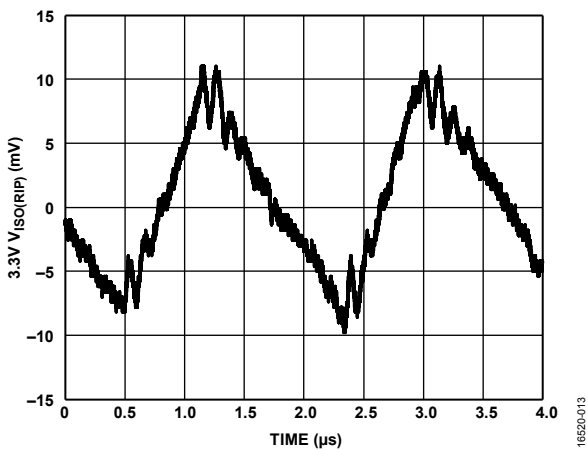


図 15. VISO リップル、90%負荷で入力 5V、出力 3.3V
帯域幅 = 20MHz

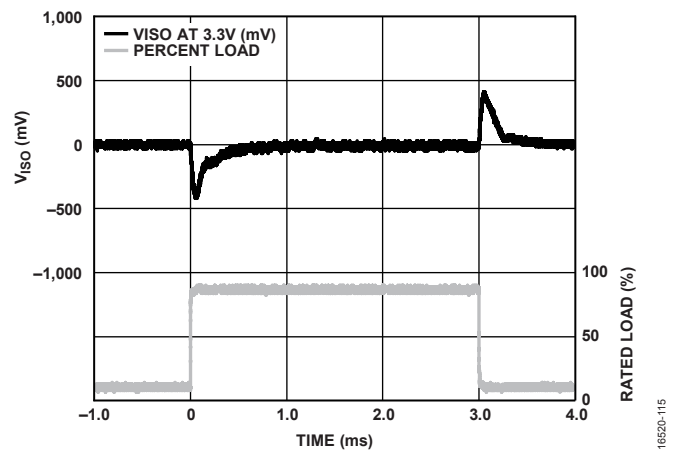


図 18. VISO 過渡負荷応答、入力 5V、出力 3.3V、10%~90%の
負荷ステップ

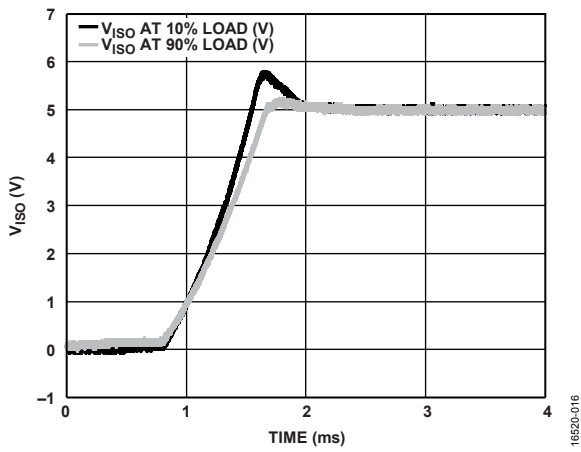


図 19. 入力 5V、出力 5V、VISO スタートアップ・トランジェント、10%と 90%の負荷

16820-016

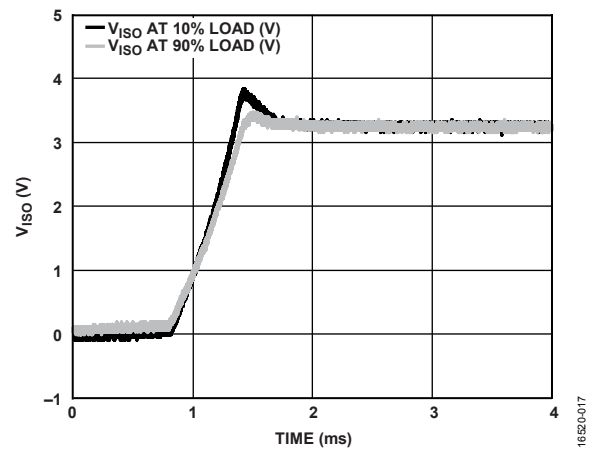


図 20. 入力 5V、出力 3.3 V、VISO スタートアップ・トランジェント、10%と 90%の負荷

16820-017

動作原理

ADuM5020/ADuM5028 DC/DC コンバータは、標準的なほとんどの電源に共通している原理で動作します。これらのコンバータは、絶縁型PWMフィードバックを備えたスプリット・コントローラ・アーキテクチャを採用しています。VDDP 電源は、チップ・スケールの空芯トランスを介して電流を切り替える発振回路を使用します。2次側に転送される電力は、VSEL ピンの設定に応じて、3.3V または 5.0V に整流されて安定化されます。2次 (V_{ISO}) 側のコントローラは、PWM 制御信号を生成することによって出力を安定化しますが、この制御信号は専用の *iCoupler* データ・チャンネル

によって1次 (V_{DDP}) 側へ送られます。PWM は、2次側に送る電力を制御するために発振回路を変調します。フィードバックを使用することで、極めて高い電力と効率が実現します。

ADuM5020/ADuM5028 は、1次側と2次側の入力出力ピンだけでなく、V_{DDP} 電源入力に、ヒステリシスを備えた低電圧ロックアウト (UVLO) を実装しています。この UVLO 機能は、ノイズの多い入力電源や、遅いパワーオン上昇率/下降率によってコンバータが発振しないようにします。

アプリケーション情報

PCB レイアウト

ADuM5020 および ADuM5028 の isoPower 内蔵 DC/DC コンバータでは、入出力の電源ピン (図 25 および 図 26 を参照) で電源のバイパスが必要になります。V_{DDP} ピンと GND₁ ピンの間では、可能な限りチップ・パッドに近い位置で、等価直列抵抗 (ESR) が小さい 0.1μF のバイパス・コンデンサが必要になります。V_{ISO} ピンと GND_{ISO} ピンの間では、可能な限りチップ・パッドに近い位置で、ESR が小さい 0.1μF または 0.22μF のコンデンサが必要になります (詳細については、図 23 および 図 24 で C_{ISO} のメモを参照してください)。電源を効果的にバイパスするには、isoPower 入力に複数の受動部品を接続すると共に、出力電圧を設定してコア電圧レギュレータをバイパスする必要があります (~ 図 26 を参照)。

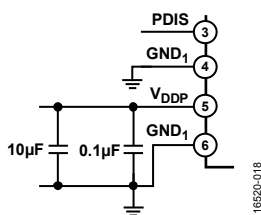


図 21. ADuM5020 V_{DDP} のバイパスおよびバイパス用部品

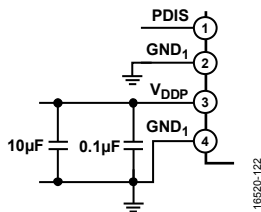
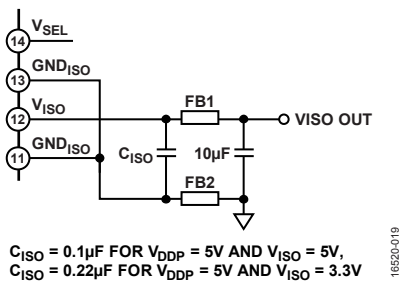
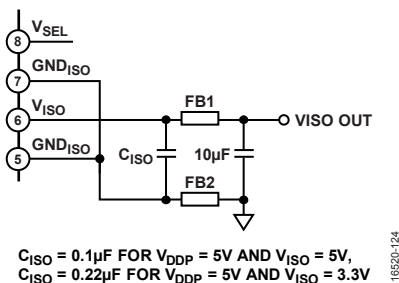


図 22. ADuM5028 V_{DDP} のバイパスおよびバイパス用部品



C_{ISO} = 0.1μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 5V,
C_{ISO} = 0.22μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 3.3V

図 23. ADuM5020 V_{ISO} のバイパスおよびバイパス用部品



C_{ISO} = 0.1μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 5V,
C_{ISO} = 0.22μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 3.3V

図 24. ADuM5028 V_{ISO} のバイパスおよびバイパス用部品

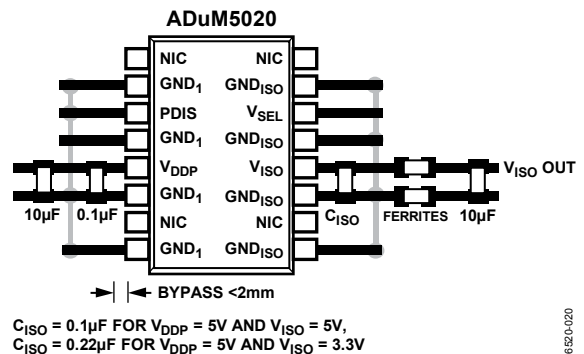
ADuM5020 および ADuM5028 の電源部分は、チップ・スケール・トランスを通して効率的に電力を受け渡すため、180MHz の発振周波数を使用しています。いくつかの動作周波数では、バイパス・コンデンサが必要になります。ノイズ抑制には低インダクタンスの高周波コンデンサが必要になり、リップル抑制や適切な安定化には大容量のコンデンサが必要になります。これらのコンデンサ

の最も便利な接続位置は、V_{DDP} ピンと GND₁ ピンの間、および V_{ISO} ピンと GND_{ISO} ピンの間になります。ノイズとリップルを抑制するには、少なくとも 2 個のコンデンサを並列に接続する必要があります。V_{DDP} および V_{ISO} に推奨されるコンデンサ容量は 0.1μF と 10μF です。コンデンサを小さくするほど、ESR の値も小さくする必要があります。例えば、セラミック・コンデンサを使用することをお勧めします。ESR が小さい 0.1μF のコンデンサを使用する場合は、コンデンサの両端と電源ピンとの間の合計リード長を 2mm 以下にする必要があります。

電磁放射レベルを下げるために、V_{ISO} ピンと GND_{ISO} ピンの間、および PCB パターン接続の間の高周波電流に対するインピーダンスを大きくすることができます。この電磁干渉 (EMI) 抑制方法を使用する場合は、および 図 26 に示すように、表面実装フェライト・ビーズを V_{ISO} ピンと GND_{ISO} ピンに対して直列に配置することによって、放射信号をその発生源で制御します。180MHz の 1 次側スイッチング周波数、および 360MHz の 2 次側整流周波数と高調波の放射を減らすには、インピーダンスが 100MHz~1GHz の周波数範囲で約 1.8kΩ となるようなフェライト・ビーズを選択します。適切な表面実装フェライト・ビーズの例については、表 18 を参照してください。

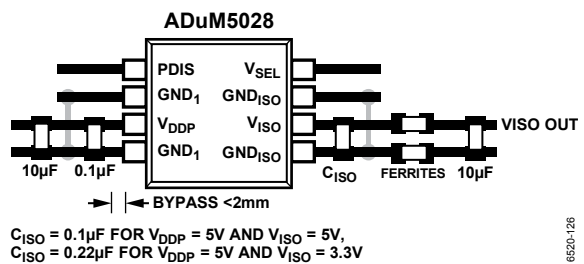
表 18. 表面実装フェライト・ビーズの例

Manufacturer	Part No.
Taiyo Yuden	BKH1005LM182-T
Murata Electronics	BLM15HD182SN1



C_{ISO} = 0.1μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 5V,
C_{ISO} = 0.22μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 3.3V

図 25. 推奨される ADuM5020 PCB レイアウト



C_{ISO} = 0.1μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 5V,
C_{ISO} = 0.22μF FOR V_{DDP} = 5V AND V_{ISO} = 3.3V

図 26. 推奨される ADuM5028 PCB レイアウト

高いコモンモード過渡電圧が発生するアプリケーションでは、絶縁バリアをまたぐボード結合を最小限に抑えてください。更に、すべての結合がデバイス側のすべてのピンで均等に発生するように PCB レイアウトを設計する必要があります。これらの手順に従わないと、ピン間で生じる電位差がに定める絶対最大定格を超えてしまい、ラッチアップまたは恒久的な損傷が発生することがあります。

熱解析

ADuM5020 および ADuM5028 は、それぞれ分割リード・フレームに取り付けた 3 個の内部ダイから構成されています。熱解析ではダイを 1 つのサーマル・ユニットとして扱い、 θ_{JA} 値にはジャンクション温度の最大値が反映されます(表 8 および表 9 を参照)。 θ_{JA} の値は、細かいパターンを使った JEDEC 規格の 4 層ボードにデバイスを実装し、自然空冷で測定した値に基づいています。通常動作の条件下では、ADuM5020 と ADuM5028 は最大負荷時でも動作できますが、温度が 85°C を超える場合、出力電流のディレーティングが必要になることがあります(図 3 および図 4 を参照)。

EMI に関する考慮事項

小型トランスを介して効率的に電力を転送するため、ADuM5020/ADuM5028 DC/DC コンバータは、必要に応じて高周波で動作する必要があります。この高周波の動作により、回路ボードのグラウンド・プレーンと電源プレーンに伝播する高周波電流が発生し、入出力の電源ピンで適切な電源バイパスが必要となります(図 25 および 図 26 を参照)。適切なレイアウトとバイパス技術を採用し、 V_{ISO} ピンと GND_{ISO} ピンに対して表面実装フェライト・ビーズを直列に配置した場合、DC/DC コンバータは、安定化された絶縁型電源を提供するように設計されています。ここでは、フェライトを搭載した 2 層 PCB に最大の負荷がかかった場合でも、CISPR22 Class B 制限を下回る安定した電力が確保されます。

絶縁寿命

すべての絶縁構造は、充分長い時間にわたり電圧ストレスを加えると、最終的には破壊されます。絶縁性能の低下率は、絶縁の両端に加える電圧波形の特性だけでなく、材料の境界面や材料自体にも依存します。

絶縁劣化には、空気にさらされる表面に沿った破壊と絶縁疲労という注目すべき 2 つのタイプがあります。表面の破壊は表面トラッキング現象で、システム・レベルの規格に定められた沿面距離条件を決定する主要な要素となります。絶縁疲労とは、チャージ・インジェクションまたは絶縁材料内部の変位電流により、長時間にわたり絶縁の劣化が生じる現象です。

表面トラッキング

表面トラッキングは電気安全規格に規定されており、動作電圧、環境条件、絶縁材料の特性に基づいて最小沿面距離を定めることによって決定されます。安全性規制当局は、部品の表面絶縁について特性評価テストを行います。これにより、部品を異なる材料グループに分類することができます。材料グループ等級が低いものほど表面トラッキングに対する耐性が高いため、小さい沿面距離で十分に長い寿命を実現できます。特定の動作電圧と材料グループに対する最小沿面距離は、各システム・レベル規格の範囲内に

あります。この値は、絶縁をまたぐ合計 rms 電圧、汚染度、材料グループに基づいています。ADuM5020 および ADuM5028 の材料グループと沿面距離を表 6 および表 7 に示します。

絶縁疲労

疲労による絶縁寿命は、厚さ、材料特性、加わる電圧ストレスによって決まります。アプリケーション動作電圧での製品寿命が十分であると確認することが重要です。アイソレータがサポートしている耐疲労動作電圧は、耐トラッキング動作電圧と異なる場合があります。トラッキングに該当する動作電圧は、ほとんどの規格で仕様規定されています。

試験とモデリングにより、長期間にわたる性能低下の主な要因は、増分型の損傷を引き起こすポリイミド絶縁体内の変位電流であることが判明しています。絶縁体にかかるストレスは、DC ストレスや、AC 成分の時間と共に変化する電圧ストレスに分類できます。前者の場合は変位電流が存在しないため、ほとんど疲労が発生しませんが、後者の場合は疲労が発生します。

認定ドキュメントに記載されている定格は、通常 60Hz のサイン波に基づいています。これは、ライン電圧からの絶縁がこのストレスに反映されるためです。ただし、多くの実用的なアプリケーションでは、バリアをまたぐ 60Hz の AC 電圧と DC 電圧の組み合わせが使用されます(式 1 を参照)。ストレスを受ける AC 部分のみが疲労を発生させるため、AC rms 電圧を求めるように式を並べ替えることができます(式 2 を参照)。これらの製品で使用されるポリイミド材料の絶縁疲労については、AC rms 電圧が製品寿命を決定します。

$$V_{RMS} = \sqrt{V_{AC\ RMS}^2 + V_{DC}^2} \quad (1)$$

または

$$V_{AC\ RMS} = \sqrt{V_{RMS}^2 - V_{DC}^2} \quad (2)$$

ここで、

V_{RMS} は、合計 rms 動作電圧。

$V_{AC\ RMS}$ は、動作電圧の時間と共に変化する部分。

V_{DC} は、動作電圧の DC オフセット。

計算とパラメータ使用の例

一般的な電力変換アプリケーションの例を以下に示します。絶縁バリアの一方に 240V ac rms のライン電圧が存在し、他方に 400V dc のバス電圧が存在するとします。絶縁材料はポリイミドです。デバイスの沿面距離、間隙、寿命を判断するために臨界電圧を求める場合は、図 27 と以降の数式を参照してください。

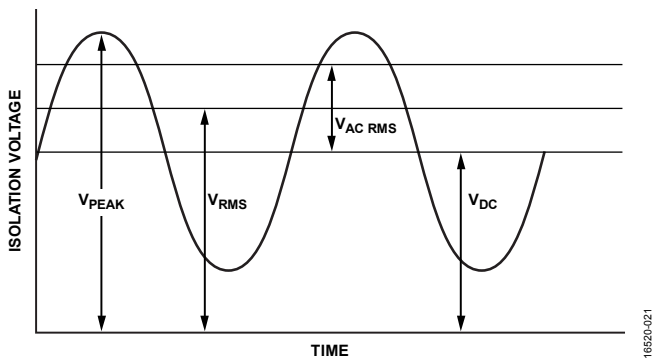


図 27. 臨界電圧の例

式 1 のバリアの両端にかかる動作電圧は、

$$V_{RMS} = \sqrt{V_{AC\ RMS}^2 + V_{DC}^2}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{240^2 + 400^2}$$

$$V_{RMS} = 466V$$

この V_{RMS} 値は、システムの規格で要求される沿面距離を求める際に、材料グループおよび汚染度と組み合わせて使用する動作電圧です。

寿命が十分であるかどうか判断するには、動作電圧の時間と共に変化する部分を求めます。AC rms 電圧を求めるには、式 2 を使用します。

$$V_{AC\ RMS} = \sqrt{V_{RMS}^2 - V_{DC}^2}$$

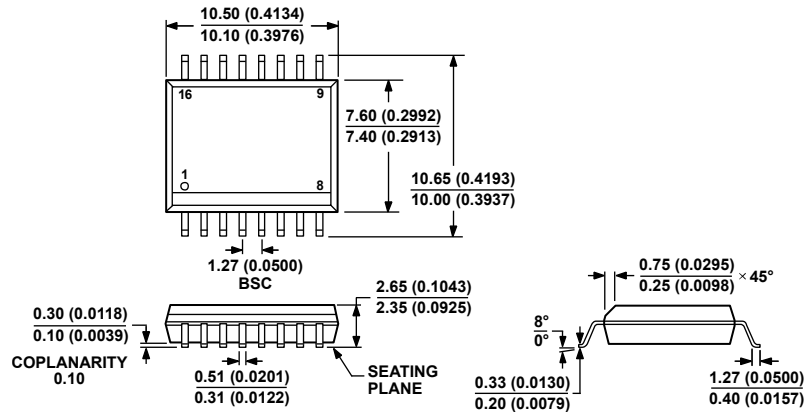
$$V_{AC\ RMS} = \sqrt{466^2 - 400^2}$$

$$V_{AC\ RMS} = 240V\ rms$$

この場合、AC rms 電圧は 240V rms のライン電圧です。この計算は、波形がサイン波でない場合は更に精度が向上します。表 14 の動作電圧の制限値とこの値を比較して期待寿命を確認すると、60Hz のサイン波の値よりも低く、50 年の運用寿命規定を十分に満たしていることがわかります。

DC 動作電圧の制限値は、IEC 60664-1 で規定されているパッケージの沿面距離によって定められています。この値は、特定のシステム・レベル規格と異なる場合があります。

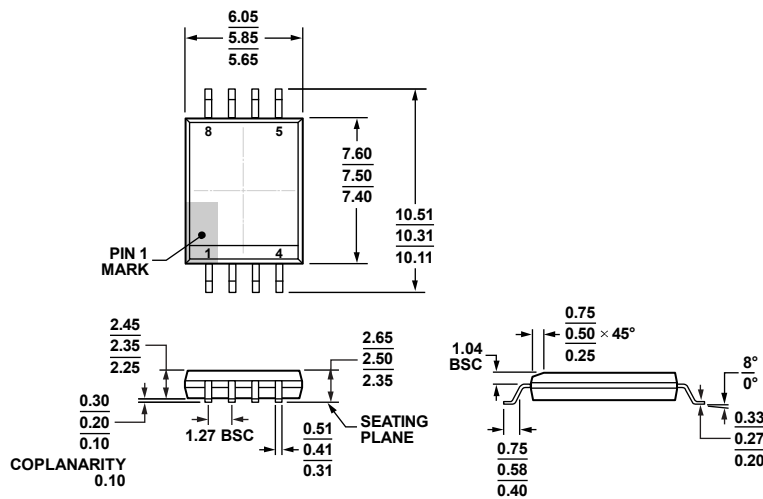
外形寸法



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-013-AA
CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

03-27-2007-B

図 28. 16 ピン、標準 SOP (スモール・アウトライン・パッケージ) [SOIC_W]
ワイド・ボディ (RW-16)
寸法単位: mm (括弧内はインチ)



09-17-2014-B

図 29. 沿面距離を増やした 8 ピン標準 SOP (スモール・アウトライン・パッケージ) [SOIC_IC]
ワイド・ボディ
(RI-8-1)
寸法: mm

オーダー・ガイド

Model ^{1, 2, 3}	Typical V _{DDP} Voltage (V)	Temperature Range	Package Description	Package Option
ADuM5020-5BRWZ	5.0	-40°C to +125°C	16-Lead SOIC_W	RW-16
ADuM5020-5BRWZ-RL	5.0	-40°C to +125°C	16-Lead SOIC_W	RW-16
ADuM5028-5BRIZ	5.0	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_IC	RI-8-1
ADuM5028-5BRIZ-RL	5.0	-40°C to +125°C	8-Lead SOIC_IC	RI-8-1
EVAL-ADuM5020EBZ			ADuM5020 Evaluation Board	
EVAL-ADuM5028EBZ			ADuM5028 Evaluation Board	

¹ Z = RoHS 準拠製品

² EVAL-ADuM5020EBZ は、ADuM5020-5BRWZ を取り付けた状態でパッケージに収納されています。

³ EVAL-ADuM5028EBZ は、ADuM5028-5BRIZ を取り付けた状態でパッケージに収納されています。